

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☒; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☒; Giảng viên thỉnh giảng ☐

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý chất rắn

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Ngô Đức Quân

2. Ngày tháng năm sinh: 6/6/1983; Nam ☒; Nữ ☐; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☐

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Bằng Doãn, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Số 103A, Nhà B, TT 170, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bru điện): Viện Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0949598996;

E-mail: quan.ngoduc@hust.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Chức vụ: Hiện nay: Giảng viên; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng Bộ môn

Cơ quan công tác hiện nay: Bộ môn Vật lý đại cương, Viện Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH ngày 23 tháng 6 năm 2006, ngành: Vật lý học, chuyên ngành: Vật lý vô tuyến

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH QGHN

- Được cấp bằng ThS ngày 24 tháng 4 năm 2009, ngành: Vật lý học, chuyên ngành: Vật lý chất rắn

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH QGHN

- Được cấp bằng TS ngày 31 tháng 08 năm 2016, ngành: Khoa học vật liệu, chuyên ngành: Vật liệu điện tử

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng II: Vật lý, Luyện kim, Hóa học)

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Vật liệu sắt điện/áp điện không chứa chì
- Vật liệu và linh kiện tích trữ năng lượng

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 3 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai);

- Đã hoàn thành 6 đề tài NCKH cấp Cơ sở;

- Đã công bố (số lượng) 27 bài báo KH, trong đó 15 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 1, trong đó 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng 0 tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
Không có			

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá):

Ứng viên tự nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn và hoàn thành các nhiệm vụ đối với đối với chức danh Phó giáo sư.

- Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc thi hành án hình sự; trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác.

- Ứng viên có 10 năm 9 tháng liên tục làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. Có đủ thời gian làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ đối với chức danh phó giáo sư;

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện đủ số giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có đủ số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu theo quy định tại khoản 9 Điều 5 Quyết định này đối với chức danh giáo sư và khoản 8 Điều 6 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ đối với chức danh phó giáo sư.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện các nhiệm vụ đối với đối với chức danh Phó giáo sư.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên *:

- Tổng số 10 năm.

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

(Căn cứ chế độ làm việc đối với giảng viên theo quy định hiện hành)

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ giảng trực tiếp/Số giờ quy đổi/Số giờ định mức
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1	2014 - 2015					171		171/196.6/0
2	2015 - 2016					398		398/570.6/270

3	2016 - 2017					738		738/851.3/270
3 năm học cuối								
4	2017 - 2018				1	524		524/573/229.5
5	2018 - 2019			1		200		200/419.6/229.5
6	2019 - 2020			2	1	338.8		338.8/600.4/229.5

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài ☐:

- Học ĐH ☐; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS ☐ hoặc luận án TS ☐ hoặc TSKH ☐; Tại nước: năm

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ☐:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☐:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ☒; Diễn giải: Đạt chứng chỉ B2 khung Châu Âu

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ B2

4. Hướng dẫn NCS, học viên CH, BSCK, BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			

1	MEMS ÁP ĐIỆN: Vật liệu và Linh kiện	CK	Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, năm 2017	7	VC	(113-184)	
---	-------------------------------------	----	---	---	----	-----------	--

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS: 0

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Nghiên cứu mô phỏng các bài toán động lực học bằng phần mềm Matlab nhằm phục vụ giảng dạy trực quan môn Vật lý đại cương 1	CN	T2010-198, cấp Cơ sở	1/4/2010 đến 15/12/2010	Ngày 15 tháng 12 năm 2010/ Xếp loại: Tốt
2	Nghiên cứu thiết kế mô phỏng cảm biến vận tốc góc kiểu Tuning Fork	CN	T2012-171, cấp Cơ sở	12/5/2012 đến 15/12/2012	Ngày 15 tháng 12 năm 2012/ Xếp loại: Tốt

3	Nghiên cứu ảnh hưởng của pha tạp Sn và Li lên tính chất của gốm áp điện không chì nền BNKT	CN	T2013-27, cấp Cơ sở	3/6/2013 đến 15/12/2013	Ngày 28 tháng 10 năm 2013/ Xếp loại: Tốt
4	Nghiên cứu chế tạo màng mỏng sắt điện không chì Bio.5(Na0.80K0.20)0.5TiO3 bằng phương pháp sol-gel	CN	T2015-119, cấp Cơ sở	16/6/2015 đến 15/12/2015	Ngày 3 tháng 11 năm 2015/ Xếp loại: Tốt
5	Nghiên cứu cải thiện tính chất của vật liệu áp điện BNKT trên cơ sở pha tạp Ta và Li	CN	T2014-111, cấp Cơ sở	03/6/2014 đến 15/12/2014	Ngày 24/9/2014, xếp loại: tốt
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tạp chất và lớp đệm tới tính chất vật lý của màng sắt điện không chứa chì nền Bio.5Na0.5TiO3	CN	T2017-LN-08, cấp Cơ sở	1/12/2017 đến 30/11/2018	Ngày 4 tháng 12 năm 2018/ Xếp loại: Đạt

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;

Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)

7.1. Bài báo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang
----	------------------------	------------	------------------	---	---	--	----------------

Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ							
1	Current development in lead-free-based piezoelectric materials	5	Có	Advances in Materials Science and Engineering, 1687-8442	Q3 - ISI IF: 1.399	62	2014
2	Band gap modification and ferroelectric properties of Bi _{0.5} (Na,K)0.5TiO ₃ -based by Li substitution	5	Có	AIP Advances, 2158-3226	Q2 - ISI IF: 1.579	25	4 , 1,
3	Nghiên cứu ứng dụng cảm biến gia tốc MEMS trong bài toán phân tích rung động	4	Có	Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009)			, 1077-1080
4	Role of dopants substitution on A-site of lead-free Bi _{0.5} (Na,K)0.5TiO ₃ -based ceramics.	7	Không	Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013)			, 195-199
5	THE ORIGINAL OF PHASE TRANSITION IN LEAD-FREE BNKT-BASED FERROELECTRIC MATERIAL	4	Có	Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013)			, 104-108
6	Hiện tượng ghim trong vật liệu gốm sắt điện nền Bi _{0.5} (Na,K)0.5TiO ₃ .	4	Có	Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013)			, 501-505
7	Influence of Grain Bound Junction on Ferroelectric Properties of Bi _{0.5} (Na,K)0.5TiO ₃ -Based by Li Substitution.	5	Có	Journal of Science and Technology			99 , 070-073.
8	Structural, ferroelectric, optical properties of A-site-modified Bi _{0.5} (Na _{0.78} K _{0.22})0.5Ti _{0.97} Zr _{0.03} O ₃ lead-free piezoceramics	6	Có	Journal of Physics and Chemistry of Solids, 0022-3697	Q2 - ISI IF: 2.752	19	77 , 62-67

9	Bipolar Electric Field Induced Strain in Li Substituted Lead-Free $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.82}\text{K}_{0.18})_{0.5}\text{Ti}_{0.95}\text{Sn}_{0.05}\text{O}_3$ Piezoelectric Ceramics	3	Có	The 2rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, 978-604-911-946-0			, 176-180
10	Preparation of Lead-Free $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.80}\text{K}_{0.20})_{0.5}\text{TiO}_3$ Ferroelectric Thin Film by Chemical Solution Deposition Method	4	Có	The 2rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, 978-604-911-946-0			, 93-9
11	Influence of Film Thickness on Ferroelectric Properties and Leakage Current Density in Lead-Free $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.80}\text{K}_{0.20})_{0.5}\text{TiO}_3$ films	3	Có	The 3rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, 978-604-95-0010-7			,
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ							
12	Effect of Zr Doping on Structural and Ferroelectric Properties of Lead-Free $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.80}\text{K}_{0.20})_{0.5}\text{TiO}_3$ Films	3	Có	Journal of Electronic Materials, 0361-5235	Q2 - ISI IF: 1.676	8	46 , 105814-5819
13	Bipolar electric field induced strain in Li substituted lead-free $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.82}\text{K}_{0.18})_{0.5}\text{Ti}_{0.95}\text{Sn}_{0.05}\text{O}_3$ piezoelectric ceramics	4	Có	Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 1533-4880	Q4 - ISI IF: 1.354	8	16 , 8, 7978-7982
14	Influence of film thickness on ferroelectric properties and leakage current density in lead-free $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.80}\text{K}_{0.20})_{0.5}\text{TiO}_3$ films	3	Có	Materials Research Express, 2053-1591	Q2 - ISI IF: 1.449	7	4 , 8, 08640
15	Influence of Crystallization Temperature on Structural, Ferroelectric, and Ferromagnetic Properties of Lead-Free $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.8}\text{K}_{0.2})_{0.5}\text{TiO}_3$ Multiferroic Films	4	Có	Advances in materials science and engineering, 1687-8442	Q3 - ISI IF: 1.399	6	2019

16	Enhanced ferroelectric properties and energy storage density in PLZT/BNKT heterolayered thin films prepared by sol-gel method	4	Có	The European Physical Journal B, 1434-6028	Q2 - ISI IF: 1.44	6	91 , 12 316
17	Influence of Crystallization Time on Energy-Storage Density and Efficiency of Lead-Free Bi _{0.5} (Na _{0.8} K _{0.2}) _{0.5} TiO ₃ Thin Films	3	Có	Advances in Condensed Matter Physics, 16878108-16878124	Q3 - ISI IF: 0.653	4	2019
18	Effect of crystallization temperature on energy-storage density and efficiency of lead-free Bi _{0.5} (Na _{0.8} K _{0.2}) _{0.5} TiO ₃ thin films prepared by sol-gel method	7	Có	Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2469-2284	Q1 - ISI IF: 3.357	2	4 , 370 375
19	Synthesizing and Studying the Structure of Ni (II) Complexes Containing 2-alkyliminomethyl Pyrene Ligands	5	Không	VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 2588-1140		1	34 , 4
20	Facile Synthesis of MnO ₂ @ SiO ₂ /Carbon Nanocomposite-based Gold Catalysts from Rice Husk for Low-Temperature CO Oxidation	7	Không	Catalysis Letters, 1572-879X	Q2 - ISI IF: 2.372		2020 , 1-8
21	Structural, ferroelectric and energy-storage properties of lead-free Zr-doped Bi _{0.5} (Na _{0.8} K _{0.2}) _{0.5} TiO ₃ films	6	Có	Surface review and letters, 1793-6667	Q4 - ISI IF: 0.748		27 , 1, 195008
22	Study on material properties of Sn-and Cu-doped ZnO thin films as n-and p-type thermoelectric materials based on wet solution synthesis	6	Không	Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 0957-4522	Q2 - ISI IF: 2.195		30 , 7, 6544- 6551
23	Influence of Excess Potassium on Structural and Ferroelectric Properties of Lead-Free Bi _{0.5} K _{0.5} TiO ₃ Thin Films	5	Có	Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 1533-4880	Q4 - ISI IF: 1.354		,

24	ẢNH HƯỞNG CỦA Zr PHA TẬP LÊN MẬT ĐỘ TÍCH TRỮ NĂNG LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT CỦA MÀNG SẮT ĐIỆN $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.80}\text{K}_{0.20})_{0.5}\text{TiO}_3$	3	Có	SPMS 2017, 978-604-95-0325-5			, 141-146
25	Structural and Ferromagnetic Properties of Lead-Free $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.80}\text{K}_{0.20})_{0.5}\text{TiO}_3\text{-BiFeO}_3$ Thin Films	2	Có	The 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology/NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA HÀ NỘI, 978-604-950-978-0			, 230-235
26	Nghiên cứu ảnh hưởng của bù natri lên tính chất của màng sắt điện không chứa chì $\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3$	6	Có	SPMS 2019/NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA HÀ NỘI, 978-604-98-7505-2			, 198-201
27	Experimental and theoretical studies on the room-temperature ferromagnetism in new (1-x) $\text{Bi}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3\text{+xCoTiO}_3$ solid solution materials	11	Không	Vacuum, 0042-207X	Q1 - ISI IF: 2.515		,

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà UV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 9

Lưu ý: Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS. 7.2. Bảng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
Không có					

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế:

TT	Tên giải thưởng	Cơ quan/tổ chức ra quyết định	Số quyết định và ngày, tháng, năm	Số tác giả
Không có				

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Cấp quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ	Vai trò	Cơ sở giáo dục đại học
Không có			

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (U'V chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (U'V chức danh PGS) ☒

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu: Vu D V, Le D H, Nguyen T T, Van Duong T, Ngo Q D, Trinh T Q, 2019, Study on material properties of Sn- and Cu-doped ZnO thin films as n- and p-type thermoelectric materials based on wet solution synthesis, Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 30, 6544-6551

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

(*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm.

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)